

4. Shirane G.—“Rev. Mod. Phys.”, 1974, vol. 46, p. 437.
5. Heiler W. R., Marcus A.—“Phys. Rev.”, 1951, vol. 84, p. 809.
6. Samara G. A.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1971, vol. 28, suppl. 399.
7. Samara G. A.—“Phys. Rev. Lett.”, 1971, vol. 27, p. 103.
8. Samara G. A.—“Ferroelectrics”, 1974, vol. 7, p. 221.
9. Kaminov I. P., Damen T. C.—“Phys. Rev. Lett.”, 1968, vol. 20, p. 1105.
10. Sugawara F., Nakamura T.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1970, vol. 28, p. 158.
11. Unoki H., Sakudo T.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1967, vol. 23, p. 546.
12. Pytte E.—“Solid State Commun.”, 1970, vol. 8, p. 2101.
13. Pytte E. Structural phase transitions and soft modes. Samuelson E. J., Andersen E. and Feder J., ed. Oslo, Universtersforlaget, 1971, p. 133—149.
14. Samara G. A., Sakudo T., Yoshimitsu K.—“Phys. Rev. Lett.”, 1975, vol. 35, p. 1767.
15. Широков А. М., Мылов В. П., Баранов А. И., Прохорцева Т. М.—«ФТТ», 1972, т. 13, с. 3108.
16. Sorge G., Schmidt G., Hegenbarth E., Frenzel Ch.—“Phys. Status Solidi”, 1970, vol. 37, p. K17.
17. Samara G. A.—“Ferroelectrics”, 1971, vol. 2, p. 277.
18. Okai B., Yoshimoto J.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1973, vol. 34, p. 873.
19. Gesi K. O., Ozawa K., Hirotsu S.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1975, vol. 38, p. 463.
20. Samara G. A.—“Phys. Rev.”, 1970, vol. B1, p. 3777; Gesi K. and Ozawa K.—“Jap. J. Appl. Phys.”, 1974, vol. 13, p. 897.
21. Samara G. A.—“Phys. Lett.”, 1968, vol. 27A, p. 232.
22. Sawada A., Takagi Y.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1971, vol. 31, p. 925; Sawada A., Takagi Y.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1972, vol. 33, p. 1071.
23. Dvorak V.—“Ferroelectrics”, 1974, vol. 7, p. 1.
24. Axe J. D., Dorner B., Shirane G.—“Phys. Rev. Lett.”, 1971, vol. 26, p. 519; Dorner B., Axe J. D., Shirane G.—“Phys. Rev.”, 1972, vol. B6, p. 1950.
25. Aizu K.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1972, vol. 33, p. 1390.
26. Janovec V., Dvorak V., Petzelt J.—“Czech. J. Phys.”, 1975, vol. B25, p. 1362.
27. Kobayashi J., Enomoto Y., Sato Y.—“Phys. Stat. Sol. (b)”, 1972, vol. 50, p. 335.
28. Unoki H., Sakudo T.—“Phys. Rev. Lett.”, 1977, vol. 38, p. 137.
29. Nakamura T., Kondo T., Kumada T.—“Phys. Lett.”, 1971, vol. 36A, p. 141.
30. Aizu K.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1969, vol. 27, p. 387.
31. Aizu K.—“Phys. Rev.”, 1970, vol. B2, p. 754.
32. Aizu K.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1974, vol. 36, p. 937.
33. Kondo T., Ishibashi Y., Takagi Y.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1975, vol. 39, p. 1326.
34. Makita Y., Sawada A., Takagi Y.—“Phys. Soc. Jap.”, 1976, vol. 41, p. 167.
35. Sawada A., Makita Y., Takagi Y.—“J. Phys. Soc. Jap.”, 1976, vol. 41, p. 174.
36. Иванов Н. Р., Шувалов Л. А., Шмидт Г., Штольп Э.—«Изв. АН СССР. Сер. физ.», 1975, т. 9, с. 933.

Поступила в редакцию 31 мая 1977 г.

УДК 535.215.12

В. И. БЕЛИНИЧЕР

(Новосибирск)

## ФОТО-ХОЛЛ-ЭФФЕКТ В КРИСТАЛЛАХ БЕЗ ЦЕНТРА СИММЕТРИИ

1. Возникновение тока в однородных сегнетоэлектриках под действием однородного освещения наблюдал А. М. Гласс с сотрудниками [1] при исследовании оптического повреждения кристаллов (см. также [2]). Теория фотогальванического эффекта (ФГЭ), обусловленного асимметрией вероятности ионизации и рекомбинации электронов в зону проводимости и асимметрией рассеяния электронов на примесях и фонах, развивалась в работах [3, 4]. ФГЭ представляет собой новое физическое явление и заслуживает подробного теоретического и экспериментального изучения. В настоящей работе мы исследуем влияние магнитного поля на фототок — фото-холл-эффект (ФХЭ). Ток, индуциро-

ванный светом в присутствии магнитного поля, описывается тензором четвертого ранга  $\gamma_{ikln}$ :

$$j_i = \gamma_{ikln} H_k E_l E_n^* \quad (1)$$

Здесь  $E_l$  — амплитуда электрического поля света,  $H_k$  — напряженность магнитного поля. Тензор  $\gamma_{ikln}$  может быть отличен от нуля только в кристаллах без центра симметрии. Действительно, при пространственном отражении левая часть соотношения (1) меняет знак, а правая — не меняет. Следовательно, тензор  $\gamma_{ikln}$  должен менять знак при пространственных отражениях, что возможно лишь в кристаллах без центра инверсии. В настоящей работе мы ограничимся рассмотрением кристаллов, у которых единственное отличие от изотропной среды заключено в полярном векторе  $c$ . В этом случае тензор  $\gamma_{ikln}$  сводится к семи функциям частоты света  $\omega$ :

$$j = HI \gamma_{hln} h_k e_l e_n \equiv HI (a_1' b + a_1'' (ce)^2 b + a_2 [h \times e] (ce) + a_3' [c \times e] (eh) + a_3'' [c \times e] (ce) (ch) + a_4' e (be) + a_4'' c (ce) (be)), \quad (2)$$

где  $I$  — интенсивность света,  $h$  — единичный вектор вдоль направления магнитного поля,  $b = [c \times h]$ ,  $e$  — вектор поляризации света, постоянные  $a_1' \div a_4''$  являются функциями частоты света  $\omega$ . При микроскопическом вычислении тензора  $\gamma_{ikln}$  будем использовать аппарат кинетических уравнений. Фототок  $j_\Phi$  следующим образом выражается через функцию распределения электронов в зоне проводимости  $f_k(x)$  ( $k$  — квазиимпульс электрона):

$$j_\Phi = \text{Sp} \left( \int d^3 k f_k \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \right). \quad (3)$$

Здесь  $\varepsilon(k)$  — закон дисперсии электрона,  $\text{Sp}$  предполагает суммирование по спиновым индексам закона дисперсии и функции распределения  $f_k$ . На равновесной функции распределения  $f_k^0$  ток обращается в нуль. Неравновесная поправка к функции распределения  $f_k^{as}$ , приводящая к фототоку, рассчитывалась в работах [3, 4]. Для расчета ФХЭ мы вычислим поправку к функции распределения  $f_k^{ah}$ , пропорциональную магнитному полю. Учтем вклады двух сортов в  $f_k^{ah}$ : холловский вклад, обусловленный силой Лоренца, действующей на электрон в зоне проводимости; специальный вклад в ток, связанный с поляризацией электронов магнитным полем и учетом влияния спин-орбитального взаимодействия на закон дисперсии электронов и рассеяние электронов на примесях. Этот вклад в ток подобен вкладу в диэлектрическую проницаемость ферромагнетиков спин-орбитального взаимодействия [5, 6]. В случае ферромагнетиков этот дополнительный вклад, как хорошо известно [5], приводит к аномальному эффекту Фарадея.

В рамках простых моделей [3, 4] будет сделан расчет различных механизмов ФХЭ и проведено сравнение их характерных особенностей.

2. Холловская поправка к функции распределения электронов в зоне проводимости может быть определена из соотношения:

$$\omega_c [k \times h] \frac{\partial}{\partial k} f_k^{as} = - \Gamma_n f_k^{ah}; \quad \omega_c \equiv \frac{eH}{mc}, \quad (4)$$

где  $m$  — масса электрона,  $\Gamma_n$  — характерная частота изотропизации электронной функции распределения по импульсу  $k$ . Для случая фотоионизации электронов с глубоких примесных уровней в  $P_0$  состоянии  $f_k^{as}$  имеет вид [3, 4]

$$f_k^{as} = \frac{2emdk}{\hbar^2 \pi |k|} f_k^s; \quad f_k^s = \frac{\kappa I (ce)^2}{\hbar \omega \Gamma_n} \left( \frac{\delta(\varepsilon_k - \varepsilon_0)}{4\pi m k_0} - \frac{\exp(-\varepsilon_k/T)}{(2\pi)^{3/2} k_T^3} \right). \quad (5)$$

Здесь  $\kappa$  — коэффициент поглощения света;  $k_T = (mT)^{1/2}$  — тепловой импульс электрона;  $k_0$  — импульс фотоионизации;  $d$  — дипольный момент примеси  $d = \xi eac$  ( $\xi$  — параметр асимметрии,  $a$  — характерный радиус). Из выражений (4), (5) легко получить

$$f_{\mathbf{k}}^{ah} = \frac{2\xi e^2 mabk}{\hbar^2 \pi |\mathbf{k}|} \frac{\omega_c}{\Gamma_H} f_{\mathbf{k}}^s. \quad (6)$$

Из (5), (6) с очевидностью следует, что фото-холловский ток в этой модели получается из обычного фотогальванического заменой  $d \rightarrow db$  и умножением на фактор  $\omega_c/\Gamma_H$ :

$$\mathbf{J}_{\text{ФХ}} = \frac{2}{3\pi} \xi \left( \frac{eI}{\hbar\Gamma_H} \right) \left( \frac{e^2}{\hbar c} \right) (k_0 a) \left( \frac{\kappa c}{\omega} \right) \frac{\omega_c}{\Gamma_H} \left( 1 - \sqrt{\frac{8}{\pi}} \frac{k_T}{k_0} \right) \mathbf{b} (e\mathbf{c})^2. \quad (7)$$

Как показано в [3, 4], рассеяние на примесях, потенциал которых представляет собой сумму короткодействующего и дипольного потенциалов, приводит к асимметричной поправке к функции распределения:

$$f_{\mathbf{k}}^{as} = \xi \left( \frac{\kappa I}{\hbar\omega} \right) \left( \frac{e^2}{\hbar c} \right) \left( \frac{Na^3}{k} \right) \frac{c\hbar^2}{\varepsilon_0 \Gamma_H^2 m} \left[ (e\mathbf{c})(\mathbf{k}e) - \frac{(\mathbf{c}\mathbf{k})(e\mathbf{k})^2}{k^2} \right] \delta(\varepsilon_{\mathbf{k}} - \varepsilon_0). \quad (8)$$

Холловский ток, обусловленный этой асимметричной поправкой к функции распределения, имеет вид

$$\mathbf{J}_{\text{ФХ}} = \frac{8\pi}{15} \xi \left( \frac{eI}{\hbar\Gamma_H} \right) (Na^3) \left( \frac{e^2 k_0}{\hbar\omega} \right) \left( \frac{k_0 \kappa \hbar}{m\Gamma_H} \right) \frac{\omega_c}{\Gamma_H} (\mathbf{b} - 3(e\mathbf{c})[\mathbf{e} \times \mathbf{h}]). \quad (9)$$

При усреднении по поляризациям ток так же, как и в [3, 4], обращается в нуль.

3. Запишем закон дисперсии электрона  $\varepsilon_{\mathbf{k}}$  с учетом спина:

$$\varepsilon_{\mathbf{k}} = \varepsilon_0 + \beta_{ij} k_i s_j + \frac{1}{2} m_{ij}^{-1} k_i k_j + \delta_{ijkl} k_i k_j k_k s_l, \quad (10)$$

где  $m_{ij}^{-1}$  — обычный тензор обратной массы, а тензоры  $\beta_{ij}$ ,  $\delta_{ijkl}$  учитывают зависимость  $\varepsilon_{\mathbf{k}}$  от спина в соответствии с инвариантностью к обращению времени:

$$\varepsilon_{\mathbf{k},s} = \varepsilon_{\mathbf{k},-s}. \quad (11)$$

Тензоры  $\beta_{ij}$ ,  $\delta_{ijkl}$  отличны от нуля только в кристаллах без центра инверсии, поскольку закон дисперсии не должен меняться при одновременной смене знака импульса и отражении осей кристалла. Ограничимся случаем кристаллов с полярной осью и не будем учитывать члены, кубичные по  $k$ , тогда

$$\varepsilon_{\mathbf{k}} = k^2/2m + \lambda[\mathbf{c} \times \mathbf{s}]\mathbf{k}, \quad \lambda \simeq \xi Z^2 (e^2/\hbar c)^3 c. \quad (12)$$

Здесь  $\lambda$  — матричный элемент спин-орбитального взаимодействия,  $\mathbf{s}$  — спиновые операторы Паули,  $c$  — скорость света,  $Z$  — заряд ядер. Оператор тока имеет вид\*

$$\mathbf{j} = e \frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{k}} = \frac{e\mathbf{k}}{m} + e\lambda[\mathbf{c} \times \mathbf{s}]. \quad (13)$$

\* Как показано в работе [6], при вычислении тока с учетом спин-орбитального взаимодействия нужна более аккуратная процедура. В данной работе мы ограничимся упрощенной трактовкой, поскольку она дает возможность правильно вычислить порядок величины эффекта.

Собственные значения энергии и собственные функции имеют вид

$$\varepsilon_{\mathbf{k}}^{\pm} = \frac{\hbar^2}{2m} \pm v; \quad \mathbf{v} = \lambda[\mathbf{k} \times \mathbf{c}]; \quad v^2 = \lambda^2(\mathbf{k}^2 - (c\mathbf{k})^2); \quad (14)$$

$$u_+ (2v(v + v_3))^{-1/2} \begin{pmatrix} v + v_3 \\ v_1 + iv_2 \end{pmatrix}; \quad u_- = (2v(v + v_3))^{-1/2} \begin{pmatrix} -v_1 + iv_2 \\ v + v_3 \end{pmatrix}.$$

Матрица  $U(\mathbf{v})$ , диагонализующая энергию, принимает вид

$$U^{\alpha\beta} \equiv u_+^{\alpha} u_-^{\beta}; \quad U(\mathbf{v}) = (2v(v + v_3))^{-1/2} \begin{pmatrix} v + v_3 & -v_1 + iv_2 \\ v_1 + iv_2 & v + v_3 \end{pmatrix}. \quad (15)$$

Оператор тока в представлении, диагонализующем энергию, имеет вид

$$\mathbf{j} = \frac{e\mathbf{k}}{m} + \frac{e\lambda}{v} [\mathbf{c} \times \mathbf{v}] s_3 + \frac{e\lambda}{v} [\mathbf{e}_3 \times \mathbf{c}] (v_1 s_1 + v_2 s_2) + \frac{1}{v(v + v_3)} ([\mathbf{e}_2 \times \mathbf{c}] (v_1 v_2 s_1 - (v^2 + vv_3 - v_2^2) s_2) + [\mathbf{e}_1 \times \mathbf{c}] (v_1 v_2 s_2 - (v^2 + vv_3 - v_2^2) s_1)).$$

Здесь  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  — единичные векторы вдоль координатных осей.

Магнитное поле вводится в гамильтониан (12) подстановкой

$$\varepsilon_{\pi} = \pi^2/2m + \lambda[\mathbf{c} \times \mathbf{s}] \pi + \omega_c \hbar s; \quad \boldsymbol{\pi} = \mathbf{k} - (e/c)\mathbf{A}. \quad (16)$$

Поскольку ФХЭ, обусловленный первым членом гамильтониана (16), был рассмотрен выше, второй член содержит релятивистскую малость по сравнению с первым, мы ограничимся учетом последнего члена с магнитным полем в (16). Этот член описывает взаимодействие магнитного момента электрона с магнитным полем. Полный гамильтониан можно записать в виде

$$\varepsilon_{\mathbf{k}} = \mathbf{k}^2/2m + \boldsymbol{\eta} \mathbf{s}; \quad \boldsymbol{\eta} = \lambda[\mathbf{k} \times \mathbf{c}] + \omega_c \hbar. \quad (17)$$

Собственные функции, энергия и вид тока в диагональном представлении получаются из формул (13)–(15) заменой  $\mathbf{v} \rightarrow \boldsymbol{\eta}$ . Гамильтониан электрона, находящегося в  $s$  состоянии на парамагнитной примеси, имеет вид

$$\varepsilon_0 = \omega_c \hbar s. \quad (18)$$

Диагонализация осуществляется по формулам (14)–(15).

4. Пусть электрон находится на парамагнитной примеси в магнитном поле. Рассчитаем фототок, возникающий в такой задаче, пропорциональный магнитному полю. Легко убедиться, что равновесная функция распределения  $f_{\mathbf{k}}^0 \sim \exp(-\varepsilon_{\mathbf{k}}/T)$  к току не приводит, согласно (3):

$$\mathbf{j}_{\Phi} = \text{Sp} \left( \int d^3k \frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{k}} \exp(-\varepsilon_{\mathbf{k}}/T) \right) = -T \text{Sp} \left( \int d^3k \frac{\partial}{\partial \mathbf{k}} [\exp(-\varepsilon_{\mathbf{k}}/T)] \right). \quad (19)$$

Поскольку подынтегральные выражения есть полная производная по  $\mathbf{k}$ , ток обращается в нуль. Обращение тока в нуль в термодинамическом равновесии естественно, однако механизм обращения тока в нуль не является тривиальным. Действительно, можно убедиться, что происходит компенсация вкладов в ток первого и второго члена в выражении (13). Это происходит благодаря явному виду равновесной функции распределения  $f_{\mathbf{k}}^0 \sim \exp(-\varepsilon_{\mathbf{k}}/T)$ . Можно ожидать, что если светом создать неравновесную симметричную добавку к функции распределения  $f_{\mathbf{k}}^0$ , то в магнитном поле возникнет ток. Действительно, в магнитном поле среднее значение спина не равно нулю, поэтому второй член в (13) приведет к току. Так как функция распределения не является равно-

весной, то вклад первого члена в ток (13) не приведет к компенсации. Вычисления в конкретных моделях подтверждают справедливость этих качественных соображений.

Рассмотрим процесс фотоионизации электронов с парамагнитных примесей в зону проводимости. Будем предполагать, что на каждую примесь приходится по одному электрону в  $s$  состоянии. Уравнение для матрицы плотности электронов в зоне проводимости в представлении собственных функций гамильтониана (17) имеет вид [7]

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho_k^{\alpha\beta}}{\partial t} = & i(\varepsilon_k^\alpha - \varepsilon_k^\beta) \rho_k^{\alpha\beta} + \frac{i(D_k e_\nu)^{+\alpha\gamma} (D_k e_\mu)^{\delta\theta}}{(\varepsilon_0^\gamma + \omega_q - \varepsilon_k^\beta - i\delta)} [\delta_{\mu\nu} (\delta_{\gamma\delta} - \rho_0^{\gamma\delta}) \rho_k^{\theta\beta} + \\ & + I_q^{\mu\nu} (\delta_{\gamma\delta} \rho_k^{\theta\beta} - \delta_{\theta\beta} \rho_0^{\gamma\delta})] + \frac{i(D_k e_\nu)^{+\theta\delta} (D_k e_\mu)^{\gamma\beta}}{(\varepsilon_k^\alpha - \omega_q - \varepsilon_0^\gamma - i\delta)} [\delta_{\mu\nu} (\delta_{\delta\gamma} - \rho_0^{\delta\gamma}) \rho_k^{\alpha\theta} + \\ & + I_q^{\mu\nu} (\delta_{\delta\gamma} \rho_k^{\theta\beta} - \delta_{\alpha\theta} \rho_0^{\delta\gamma})] - \Gamma_n (\rho_k^{\alpha\beta} - \bar{\rho}_k^{\alpha\beta}). \end{aligned} \quad (20)$$

Здесь  $\rho_0^{\alpha\beta}$  — матрица плотности электрона на примеси;  $I_q^{\mu\nu}$ ,  $\omega_q$ ,  $e_\nu$  — матрица плотности, частота и поляризация света;  $D_k^{\alpha\beta}$  — матричный элемент дипольного момента примесь — зона в представлении, диагонализующем гамильтониан;  $\Gamma_n$  — характерная частота изотропизации матрицы плотности по изоэнергетической поверхности благодаря столкновению с фононами и примесями. Обычно хорошо выполняется соотношение  $\varepsilon_k^\alpha - \varepsilon_k^\beta \gg \Gamma_n$  для  $\alpha \neq \beta$ , поэтому в стационарном состоянии диагональные элементы матрицы плотности намного больше недиагональных. Мы учтем вклад в ток только диагональных компонент матрицы плотности. Матрицы плотности  $\rho_0^{\alpha\beta}$ ,  $I_q^{\mu\nu}$  также выберем диагональными. Будем считать, что  $\rho_0^{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta} f_0^\alpha$  мало отличается от равновесной, а  $I_q^{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} I_q^\nu$  задает плотность фотонов. Для диагональных элементов матрицы  $\rho_k^{\alpha\beta} |_{\beta=\alpha} = f_k^\alpha$  уравнение (20) сводится к обычному кинетическому уравнению

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_k^\alpha}{\partial t} = & \frac{N}{2\pi} \sum_{\gamma, \nu} \int d^3q \omega_q (D_k e_\nu)^{+\alpha\gamma} (D_k e_\nu)^{\gamma\alpha} \delta(\varepsilon_0^\gamma + \omega_q^\nu - \varepsilon_k^\alpha) \times \\ & \times [I_q^\nu (f_0^\nu - f_k^\alpha) - f_k^\alpha (1 - f_0^\nu)] - \Gamma_n (f_k^\alpha - \bar{f}_k^\alpha). \end{aligned} \quad (21)$$

Отметим, что матричные элементы дипольного момента  $D_k^{\alpha\beta}$  имеют вид

$$D_k^{\alpha\beta} = D_k Q^{\alpha\beta}; \quad Q^{\alpha\beta} = U^{-1} (\hbar)^{\alpha\gamma} U (\eta)^{\gamma\beta}. \quad (22)$$

Здесь  $D_k$  — матричный элемент дипольного момента без учета спин-орбитального взаимодействия, матрица  $U(a)$  определена соотношением (15). Приравняв  $\frac{\partial f_k^\alpha}{\partial t} = 0$ , мы сможем из уравнения (21) определить неравновесную поправку к функции распределения. Равновесные функции распределения, входящие в (21), имеют вид

$$\begin{aligned} f_k^\alpha = & \frac{\kappa I}{2\hbar\omega (2\pi)^{3/2} k_T^3} \exp(-\varepsilon_k^\alpha/T); \quad \sum_\alpha \int f_k^\alpha d^3k = \frac{\kappa I}{\hbar\omega}; \\ f_0^\alpha = & \frac{1}{2} \exp(-\alpha\omega_c/T); \quad I_q^\nu = \frac{I\delta_{\nu\nu_0}}{\hbar\omega c} \delta^3(q - q_0). \end{aligned} \quad (23)$$

Формулы (23) справедливы с точностью  $0(\omega_c^2/T^2)$ ,  $0(\lambda^2 m/T)$ . Для перехода электрона с примеси в  $s$  состоянии в  $s$  зону при  $ka \ll 1$  ( $a$  — радиус

примеси) матричный элемент дипольного момента может быть представлен в виде

$$D_k = igk; \quad g^2 = \frac{3c\hbar^2\kappa}{2k_0^3 m \omega N_0}. \quad (24)$$

Неравновесная поправка к функции распределения  $f_k^{\alpha h}$ , приводящая к току с точностью  $0(\omega_c/T)$ ,  $0(\omega_c/\lambda k)$ ,  $0(\lambda m/k)$ , может быть записана как

$$\begin{aligned} \delta f_k^{\alpha h} &= \delta f_k^{\alpha hu} + \delta f_k^{\alpha hp}; \quad \delta f_k^{\alpha hp} = \alpha \frac{\kappa \Gamma_{\text{H}}^{-1}}{\hbar \omega (2\pi)^{3/2} k_T^3} \frac{\omega_c \hbar \nu}{T \nu} \exp(-\varepsilon_k/T); \\ \delta f_k^{\alpha hu} &= \frac{3\kappa l (ke)^2}{8\pi k_0^3 m \hbar \omega \Gamma_{\text{H}}} \left[ \alpha \frac{\omega_c \hbar \nu}{T \nu} \delta(\varepsilon_0 + \omega - \varepsilon_k) - \left( \alpha \nu + \omega_c \frac{\hbar \nu}{T} \right) \times \right. \\ &\quad \left. \times \delta'(\varepsilon_0 + \omega - \varepsilon_k) - \omega_c \hbar \nu \delta''(\varepsilon_0 + \omega - \varepsilon_k) \right]. \end{aligned} \quad (25)$$

При выводе (25) мы воспользовались следующими формулами суммирования для  $Q$  матриц:

$$Q^{+\alpha\gamma} Q^{\gamma\alpha} = 1; \quad Q^{+\alpha\gamma} Q^{\gamma\alpha} = \alpha \hbar \eta / \eta \approx \alpha \hbar \nu / \nu.$$

Диагональные члены в выражении для тока с той же точностью, что и (25), имеют вид

$$j_\alpha = \frac{ek}{m} + \alpha \frac{e\lambda}{\nu} \left[ \left( 1 - \frac{\omega_c \hbar \nu}{\nu} \right) [c \times v] + \omega_c b \right]. \quad (26)$$

Подставляя выражение для  $j_\alpha$  и  $\delta f_k$  в (3), окончательно получим

$$j = \frac{1}{2} \left( \frac{el}{\hbar \Gamma_{\text{H}}} \right) \left( \frac{\kappa \lambda}{\omega} \right) \frac{\omega_c}{T} \left[ \left( 1 - \frac{7}{2} \frac{k_T^2}{k_0^2} \right) b + \frac{k_T^2}{k_0^2} e (be) - \left( 2 + 3 \frac{k_T^2}{k_0^2} \right) c (be) (ce) \right]. \quad (27)$$

5. Одновременно с процессами ионизации и рекомбинации учет спиновых эффектов в рассеянии также приводит к току. Действительно, при среднем спине электрона, отличным от нуля, возникает добавка к энергии взаимодействия электрона с примесью  $\Delta E = -\mu H$  ( $\mu$  — магнитный момент электрона,  $H$  — магнитное поле в системе покоя электрона). Это магнитное поле можно выразить через электрическое поле примеси и скорость электрона  $H = c^{-1} [v \times E]$ . Добавка к энергии примет вид

$$\Delta E = c^{-1} \mu [v \times E].$$

Эта добавка представляет собой энергию спин-орбитального взаимодействия и приводит к дополнительной силе, действующей на электрон:

$$\Delta F_i = c^{-1} \nabla_i E [v \times \mu] + c^{-1} [\mu \times \nabla_k E]_i v_k.$$

Если электрическое поле  $E$  асимметрично, как, например, поле диполя, то добавка к силе  $\Delta F_i$  приведет к дополнительному асимметричному рассеянию и вкладу в ток, пропорциональному  $\mu$ , т. е. внешнему магнитному полю.

Уравнение для матрицы плотности электронов, описывающее процесс рассеяния электронов на примесях в представлении, диагонализующем энергию, записывается [7] таким образом:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho_k^{\alpha\beta}}{\partial t} &= i(\varepsilon_k^\alpha - \varepsilon_k^\beta) \rho_k^{\alpha\beta} + iN \int d^3k' [(V_{kk'}^{\alpha\gamma} V_{k'k}^{\gamma\delta} \rho_k^{\delta\beta} - V_{kk'}^{\alpha\gamma} V_{k'k}^{\delta\beta} \rho_k^{\gamma\delta}) \times \\ &\quad \times (\varepsilon_{k'}^\gamma - \varepsilon_k^\beta - i\delta)^{-1} + (V_{kk'}^{\gamma\delta} V_{k'k}^{\delta\beta} \rho_k^{\alpha\gamma} - V_{kk'}^{\alpha\gamma} V_{k'k}^{\delta\beta} \rho_k^{\gamma\delta}) (\varepsilon_k^\alpha - \varepsilon_{k'}^\delta - i\delta)] - \\ &\quad - \Gamma_{\text{H}} (\rho_k^{\alpha\beta} - \bar{\rho}_k^{\alpha\beta}). \end{aligned} \quad (28)$$

Будем предполагать, что  $\varepsilon_k^\alpha - \varepsilon_k^\beta \gg \Gamma_H$ , и вычислять интеграл столкновений на диагональной матрице плотности  $\rho_k^{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta} f_k^\alpha$ . В этом случае уравнение (28) сводится к обычному кинетическому уравнению

$$\frac{\partial f_k^\alpha}{\partial t} = (2\pi)^{-2} N \int d^3 k' V_{kk'}^{\alpha\gamma} V_{k'k}^{\gamma\alpha} (f_{k'}^\gamma - f_k^\alpha) \delta(\varepsilon_k^\alpha - \varepsilon_{k'}^\gamma) - \Gamma_H (f_k^\alpha - \bar{f}_k^\alpha). \quad (29)$$

Энергию взаимодействия электрона с примесью запишем с учетом спин-орбитального взаимодействия:

$$V(\mathbf{r}) = v(\mathbf{r}) - (\hbar/8m^2c^2) [\nabla v \times \mathbf{p}] \cdot \mathbf{s}. \quad (30)$$

Потенциал примеси  $v(\mathbf{r})$  выберем так же, как и в [3, 4], в виде суммы короткодействующего потенциала и дальнедействующего дипольного:

$$v(\mathbf{r}) = (2\pi/m) a \delta^3(\mathbf{r}) + \mathbf{e} \mathbf{d} \mathbf{r} / \varepsilon_0 r^3; \quad \mathbf{d} = \xi \mathbf{e} a c. \quad (31)$$

Здесь  $a$  — длина рассеяния на короткодействующем потенциале,  $\varepsilon_0$  — диэлектрическая постоянная кристалла,  $\xi$  — параметр асимметрии рассеивающего центра. В линейном по спин-орбитальному взаимодействию приближении поправка к функции распределения может быть записана так:

$$\delta f_k^\alpha = \frac{N a^2}{m^2 \Gamma_H} \int d^3 k' (Q_{kk'}^{+\alpha\gamma} Q_{k'k}^{\gamma\alpha} + (Q_{kk'}^{+\alpha\gamma} T_{k'k}^{\gamma\alpha} + \text{К. С.})) \delta(\varepsilon_k^\gamma - \varepsilon_k^\alpha) (f_{k'}^\gamma - f_k^\alpha), \quad (32)$$

где

$$Q_{kk'}^{\alpha\beta} = U^{-1}(\eta')^{\alpha\gamma} U(\eta)^{\gamma\beta}; \quad T_{k'k} = u U^{-1}(\eta') \mathbf{s} [\mathbf{k} \times \mathbf{k}'] U(\eta); \\ u = (4\varepsilon_0)^{-1} (e^2/\hbar c) (\hbar/mc) \mathbf{c}(\mathbf{k} - \mathbf{k}') / (\mathbf{k} - \mathbf{k}')^2;$$

$U(\eta)$  определено формулой (15). Учет симметричного потенциала в спин-орбитальном члене не приводит к асимметрии в первом порядке по спин-орбитальной константе. При расчете матричного элемента дипольного спин-орбитального взаимодействия мы учли вклад только больших расстояний при вычислении матричного элемента, однако вклад малых расстояний может быть тоже существен [6].

Из явного выражения для поправки к функции распределения электронов  $\delta f_k^\alpha$  видно, что имеется два вклада в  $\delta f_k^\alpha$ : короткодействующий вклад от обычного рассеяния и вклад от асимметричного спин-орбитального рассеяния. Рассчитаем первый вклад точно, а для второго приведем оценку по порядку величины. Симметричную функцию распределения  $f_k^\alpha$ , входящую в (32), выберем для простоты не зависящей от индекса  $\alpha$ :

$$f_k = \frac{3(ke)^2 \kappa I}{8\pi \hbar \omega m k_0^3 \Gamma_H} \delta(\varepsilon_k - \varepsilon_0). \quad (33)$$

Подставив (33) в (32) и воспользовавшись формулами суммирования для величин  $Q$  и  $T$ :

$$Q_{kk'}^+ Q_{k'k} = 1; \quad Q_{kk'}^+ \sigma_3 Q_{k'k} = \sigma_3 \eta \eta' / \eta \eta'; \\ Q_{kk'}^+ T_{k'k} = \sigma_3 \eta [\mathbf{k} \times \mathbf{k}'] / \eta; \quad Q_{kk'}^+ \sigma^3 T_{k'k} = u (\eta' [\mathbf{k} \times \mathbf{k}'] / \eta' + \\ + \sigma_3 [\eta' \times [\mathbf{k} \times \mathbf{k}']] \eta / \eta \eta'), \quad (34)$$

получим

$$\delta f_k^{1\alpha} = \frac{\kappa I N a^2}{2 \hbar \omega m k_0^4 \Gamma_H^2} \left( -3(ke)^2 \left( \alpha v + \frac{\omega_c \hbar v m}{k^2} \right) \delta(\varepsilon_k - \varepsilon_0) + \right. \\ \left. + (k_0^4/m) (\alpha v \delta'(\varepsilon_k - \varepsilon_0) - \omega_c \hbar v \delta''(\varepsilon_k - \varepsilon_0)); \right) \quad (35) \\ \delta f_k^{2\alpha} \approx \xi \frac{\kappa I (k_0 a)}{\hbar^2 \omega m k_0 \Gamma_H} \left( \frac{e^2}{\hbar c} \right)^3 (V a^3) \left( \frac{c}{\Gamma_H} \right) \delta(\varepsilon_k - \varepsilon_0) \mathbf{b} \mathbf{k} + \dots$$

Здесь  $\delta f_k^{\alpha}$  соответствует первому члену в (32), а  $\delta f_k^{2\alpha}$  — второму. Используя выражение (35) для  $\delta f_k^{\alpha}$  и формулы (3), (26) для тока, получим

$$j_1 = (4\pi/15) (eI/\hbar\Gamma_n) (\kappa\lambda/\omega) (Na^2/k_0) (\omega_c/\Gamma_n) [7e(\mathbf{be}) - 6\mathbf{b} - 5c(\mathbf{ce})(\mathbf{be})];$$

$$j_2 \approx \xi (eI/\hbar\Gamma_n) (k_0a)^2 (Na^2/k_0) (e^2/\hbar c)^3 (c\kappa/\omega) (\omega_c/\Gamma_n) \mathbf{b} + \dots \quad (36)$$

6. Для сравнения полученных результатов обозначим характерную величину тока, связанную с фотоионизацией с парамагнитными примесями, через  $j_0 = \xi (e/\hbar c) (k_0a) (\kappa c/\omega) (eI/\hbar\Gamma_n)$ . Фототок, обусловленный силой Лоренца, отличается от  $j_0$  в параметр  $\omega_c/\Gamma_n$  (7); фототок, связанный со спиновыми эффектами, — в  $(Ze^2/\hbar c)^2 (ak_0)^{-1} (\omega_c/T)$  (27). При высоких температурах ( $T > \Gamma_n$ ) доминирует обычный холловский ток, при низких  $T \leq \omega_c$  — аномальный и спиновый вклад в ток, который для случая кристаллов с большим  $Z$  может составлять величину, сравнимую с обычным, не зависящим от магнитного поля фототоком. В случае рассеяния на примесях обычный холловский вклад имеет малость  $\omega_c/\Gamma_n$  (9), а спиновый вклад отличается от него в параметр  $(Ze^2/\hbar c)^2 (k_0a)^{-1} (m\Gamma_n/k_0^2)$  (36). Эти два механизма ФХЭ сравнимы по величине только при малых  $k_0$ , т. е. на краю поглощения.

Автор благодарит В. К. Малиновского и Б. И. Стурмана за полезные обсуждения.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Glass A. M., Von der Linde D., Auston D. H., Negran T. J. High-voltage bulk photovoltaic effect and photorefractive process in LiNbO<sub>3</sub>.— "Appl. Phys. Lett.", 1974, vol. 25, p. 233; Excited state polarization and bulk photovoltaic effect.— "J. Elect. Mater.", 1975, vol. 4, N 5, p. 915.
2. Fridkin V. M., Grekov A. A., Ionov P. V., Rodin A. I., Savrenko E. A. and Verkhovskaya K. A. Photoconductivity in certain ferroelectrics.— "Ferroelectrics", 1974, vol. 8, p. 483.
3. Белиничер В. И., Малиновский В. К., Канаев И. Ф., Стурман Б. И. Фотондуцированные токи в сегнетоэлектриках.— «Автоматрия», 1976, вып. 4, с. 23.
4. Белиничер В. И., Малиновский В. К., Стурман Б. И. Фотогальванический эффект в кристаллах с полярной осью.— «ЖЭТФ», 1977, т. 73, с. 692.
5. Соколов А. В. Оптические свойства металлов. М., Физматгиз, 1961.
6. Белиничер В. И. Магнитооптические эффекты в ферромагнетиках и вид оператора тока.— «ФММ», 1977, т. 43, вып. 5, с. 903.
7. Вопросы квантовой теории необратимых процессов. Под ред. В. Л. Бонч-Бруевича. М., ИЛ, 1961.

Поступила в редакцию 17 августа 1977 г.

УДК 535.215.12

В. И. БЕЛИНИЧЕР, А. Н. ФИЛОНОВ

(Новосибирск)

#### МОДЕЛИ ПРИМЕСНЫХ ЦЕНТРОВ В ТЕОРИИ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

1. В работах [1] была предложена теория фотогальванического эффекта (ФГЭ) нового оптического явления, недавно обнаруженного экспериментально [2]. Фототок в [1] связывался с асимметрией вероятности ионизации и рекомбинации (АИР) электронов в зону проводимо-